

Title (en)

Low temperature corrected voltage generating device

Title (de)

Niedrigtemperaturkorrigierte Spannungsgeneratoreinrichtung

Title (fr)

Dispositif générateur de tension corrigé à basse température.

Publication

**EP 1102148 A1 20010523 (FR)**

Application

**EP 00403128 A 20001110**

Priority

FR 9914284 A 19991115

Abstract (en)

The circuit has a component sensitive to low temperature changes in order to control the amplifier final output voltage. The constant voltage generator comprises a reference voltage generator (110) and an amplifier (126) connected between this reference voltage generator and the output terminal. A voltage divider (130) is connected to one input of the amplifier to provide a feedback voltage. The voltage divider comprises at least a first resistance (132) in series with an element (150) whose resistance varies as a function of the prevailing low temperature. The temperature dependence of this resistance value is different from that of the first resistance (132) and thus this provides a feedback which is smaller in the lower part of the temperature range.

Abstract (fr)

Dispositif générateur de tension constante corrigé à basse température comprenant : un générateur de tension de référence (110), un amplificateur (126) connecté entre le générateur de tension de référence et une borne de sortie, un diviseur de tension (130) et relié à une entrée de l'amplificateur pour fournir à l'amplificateur une tension de contre-réaction, Conformément à l'invention le diviseur comprend au moins une première résistance (132) en série avec un élément (150) présentant, au moins dans ladite gamme de températures basses, une impédance avec un comportement de dépendance en température différent de celui de ladite première résistance de façon à fournir une contre-réaction plus faible dans ladite gamme de températures basses. <IMAGE>

IPC 1-7

**G05F 3/30**

IPC 8 full level

**G05F 3/30** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**G05F 3/30** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 5291122 A 19940301 - AUDY JONATHAN M [US]
- [A] EP 0552964 A2 19930728 - SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC [US]
- [A] US 5359233 A 19941025 - MUMPER ERIC W [US], et al
- [A] US 5373226 A 19941213 - KIMURA KATSUJI [JP]
- [A] US 4939442 A 19900703 - CARVAJAL FERNANDO D [US], et al

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 1102148 A1 20010523; EP 1102148 B1 20050504;** DE 60019878 D1 20050609; DE 60019878 T2 20060216; FR 2801116 A1 20010518; FR 2801116 B1 20020125; US 6407638 B1 20020618

DOCDB simple family (application)

**EP 00403128 A 20001110;** DE 60019878 T 20001110; FR 9914284 A 19991115; US 70296700 A 20001031